

国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等利用約款

制定 平成25年12月1日
最終改正 令和4年8月1日 一部改正

(適用範囲)

第1条 この約款は、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）が保有する研究施設、研究設備及び研究装置であつて、別表第1に掲げるもの（以下「共用施設等」という。）を国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等の利用に関する規程（25規程第60号）及び共用施設等の登録、公開及び利用に係る業務実施要領（27要領第123号）に基づき、利用する場合に適用します。

(定義)

- 第2条 この約款において「利用」とは、利用者が、研究所内において共用施設等を用いてデータ等の取得及び試料等の処理等を行うこと（第5条第1項の役務提供、同条第2項の技術指導及び同条第3項の技術代行を受ける場合を含む。）をいいます。
- 2 この約款において「利用者」とは、第3条第2項の規定に基づき研究所との間で共用施設等の利用契約を締結した者をいいます。
- 3 この約款において「利用希望者」とは、共用施設等の利用を希望する者であつて、研究所との間で利用契約を締結していない者をいいます。
- 4 この約款において「役職員等」とは、研究所の役員、職員及び契約職員並びに研究所の業務を行う者であつて役員、職員及び契約職員以外の者をいいます。
- 5 この約款において「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程（13規程第26号。以下「職務発明取扱規程」という。）第2条に規定する権利、著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他の知的財産（知的財産基本法（平成14年法律第122号）第2条第1項の知的財産をいう。）に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
- 6 この約款において「秘密情報」とは、研究所又は利用者が相手方に開示した技術情報及び自己の事業に係る技術情報以外の情報であつて、秘密である旨の表示がなされている書類又は電磁的記録（複製されたものを含む。）及び口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で開示者から開示内容を特定のうへ秘密である旨通知されたものをいいます。ただし、次の各号の一到七に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- 一 相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
 - 二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
 - 三 相手方から情報を知得した時点で既に自己が保有していたことを書面により立証できる情報
 - 四 相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面により立証できる情報
 - 五 相手方から開示を受けた後、相手方が秘密である旨示した情報によらず、独自に創出した情報
 - 六 相手方から書面により開示の承諾を得た情報
 - 七 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報
- 7 この約款において「発明等」とは、職務発明取扱規程第2条第7項に規定するものをいいます。

(利用の方法)

- 第3条 共用施設等の利用希望者は、あらかじめ研究所における当該共用施設等の施設管理者（以下「施設管理者」という。）の内諾を得た上で、研究所が別に指定する共用施設等利用申込書（以下、「利用申込書」という。）を提出してください。ただし、利用申込書の提出に当たっては、利用希望者と共用施設等を利用する役員及び従業員は同一の機関に所属していなければなりません。
- 2 研究所は、次に掲げる要件が全て満たされていると認める場合には、共用施設等利用回答書（以下「回答書」という。）により利用を受け入れることを通知します。この通知により、研究所と利用希望者との間に本約款に基づく共用施設等の利用契約（以下「本利用契約」という。）が成立するものとします。
- 一 利用希望者が、反社会的勢力等と関係を有していないこと。
 - 二 利用希望者及び利用目的に関して、安全保障輸出管理上及び情報管理上の懸念がないこと。
 - 三 利用が、研究所の研究業務に支障を来すおそれがないこと。
 - 四 利用が、我が国の産業競争力を損なうおそれがないこと。
 - 五 前各号に掲げるもののほか、共用施設等の利用が不相当と認められる特段の事由がないこと。
- 3 研究所は、前項各号に掲げる要件が満たされていることを認めるに当たり、第三者の意見を聞くことができます。

4 研究所は、第2項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない場合には、回答書により受入れができないことを通知します。

(利用の受入れの取消し又は中止及び事実の公表)

第4条 研究所は、前条第2項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない事態が生じ、又は利用者が第8条第1号から第6号まで及び第8号のいずれかに違反した場合には、利用者に対し、前条第2項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。

2 研究所は、前項の規定にかかわらず、研究所が管理上の必要があると認める場合には、利用者に対し、前条第2項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。

3 研究所は、第1項の規定により利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命じた場合には、これらの事実を公表することができます。

4 本利用契約は、第1項及び第2項の規定による利用の受入れの取消し又は利用中止命令により、解除されたものとします。

(役務提供、技術指導及び技術代行)

第5条 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、共用施設等の操作、運転等の役務提供を利用者に実施することができます。

2 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、共用施設等の操作及び運転方法、実験試料等の作製方法、実験データ等の解析方法等に関する技術指導を利用者に実施することができます。

3 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を利用者に実施することができます。

4 利用者は、利用に際し研究所に登録された知的財産権の開示又は実施許諾を受ける必要がある場合には、研究所と別途、当該開示又は実施許諾に係る契約を締結するものとします。

(利用料等)

第6条 利用者は、次の各号の合計額に消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を加えた額（以下「利用料等」という。）を所定の期日までに納付するものとします。ただし、文部科学省からの委託事業「マテリアル先端リサーチインフラ」対象事業（以下「文部科学省委託事業」という。）のために共用施設等を利用する場合の利用料等に関しては、第6号の運営管理費は含まないものとします。

- 一 共用施設等使用料
- 二 運転費（前条第1項に係る費用）
- 三 技術指導費（前条第2項に係る費用）
- 四 技術代行費（前条第3項に係る費用）
- 五 追加料金
- 六 運営管理費

2 研究所は、利用者が文部科学省委託事業のために共用施設等を利用する場合の利用料等の単価は、通常の単価より低いものを設定します。

3 利用者は、第16条第1項ただし書により成果の公開をしないこととした場合には、研究所が指定する日までに通常の単価により算定される額から前項の規定による低い単価により算定される額を控除した額及び通常の単価により算定される第1項第6号の運営管理費を納付するものとします。

4 第1項及び第2項の利用料等の算定方式については、共用施設等ごとに別紙第1に定めるものとします。

5 研究所は、利用者の従業員であって共用施設等の利用に携わる者を研究所に受け入れた場合において、前4項に加え、連携研究等経費算定要領（19要領第15号）別表第3に定める人頭経費を徴収する場合があります。

(利用料等の返還)

第7条 研究所は、原則として利用者が納付した利用料等を返還しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用した期間に応じて、当該利用料等の全部又は一部を返還します。

- 一 利用者の責によらない共用施設等の故障又は天災等のやむを得ない事情により、当該共用施設等の利用が不可能になった場合
- 二 第4条第2項の規定により、研究所が利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命じた場合
- 三 利用料等の納付方法が利用前払い及び精算方式の場合であって、利用した期間が回答書に記載した利用の期間より短い場合で、研究所が返還の必要性があると認めた場合

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守してください。

- 一 本約款及び回答書に記載されている事項

- 二 施設管理者の指示及び共用施設等ごとに定められている利用に際して守るべき事項
- 三 危険を惹起する行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
- 四 日本国の法令に違反する行為を行わないこと。
- 五 共用施設等を破損するおそれがある行為を行わないこと。
- 六 研究所の業務遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
- 七 利用終了時には、共用施設等を利用開始前の状態に復帰させること。
- 八 その他、研究所の定める事項

(秘密情報の取扱い等)

第9条 研究所及び利用者は、相手方が開示した秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、書面による相手方の承諾なくして、第三者に漏洩しないものとします。

- 2 研究所及び利用者は、秘密情報の管理について、取扱責任者を定め厳重に管理します。
- 3 研究所及び利用者は、研究所の役職員等又は利用者の従業員であって共用施設等の利用に携わる者に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、開示に際し、秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに、当該研究所の役職員等又は利用者の従業員は、研究所及び利用者が本約款に基づき負うと同様の義務を負うものとします。
- 4 利用者は、研究所の開示した秘密情報による発明等又は研究所の開示した秘密情報を含む発明等を創製した場合には、直ちに研究所にその旨を通知するものとし、研究所及び利用者は当該発明等の取扱いについて協議することとします。
- 5 利用者が研究所に開示する秘密情報は、共用施設等の利用目的に照らし必要最小限の範囲に留めなければなりません。
- 6 利用者は、盗聴、盗撮、リバースエンジニアリングその他の正当ではない手段を用いて、研究所又は他の利用者等の第三者の技術情報にアクセスする行為を行ってはなりません。

(成果の帰属)

第10条 利用者の利用により得られた知的財産権は、原則として利用者に帰属するものとします。ただし、研究所から第5条第2項の技術指導若しくは同条第3項の技術代行を受けた場合又は当該知的財産権が共用施設等若しくは研究所が予め用意したその操作、運転等の方法に係るものである場合には、研究所及び利用者は協議することとします。

- 2 前項において、研究所と利用者との協議により、利用により得られた知的財産権の一部又は全部が研究所に帰属することとなった場合には、その取扱いについて別途契約により定めることとします。
- 3 第1項ただし書の規定にかかわらず、利用者が共用施設等を利用し、新たに有体物を作成した場合には、当該有体物に研究所の材料又は試料を用いる場合を除き、当該有体物は利用者に帰属するものとします。
- 4 利用者は、利用により第1項の協議の対象となる発明等を創製した場合には、研究所に報告するものとします。

(事故処理)

第11条 利用者は、共用施設等の利用中に事故、緊急事態等が発生した場合には、直ちに研究所に通報し、その指示に従わなければなりません。

(免責)

第12条 研究所は、共用施設等の利用により又は利用に伴い発生した事故及び事件等に起因して利用者又は第三者に生じた損害について、損害賠償責任を含む一切の法的責任を負いません。ただし、研究所が意図的に当該事故及び事件等を惹き起こした場合には、この限りではありません。

- 2 研究所は、共用施設等の故障、不具合等により生じた利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 3 研究所は、第4条第1項及び第2項に定める利用の受入れの取消し又は利用中止命令に起因して又は関連して生じた利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 4 研究所は、利用者が持ち込んだ試料等の滅失又は毀損に対しては、研究所の故意又は重大な過失による場合を除き、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 5 利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者は自らの費用と責任により当該紛争を解決するものとし、研究所は損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 6 研究所が損害賠償責任を負う場合には、その範囲は直接及び通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、特別損害及び間接損害は含みません。

(弁償義務)

第13条 利用者の故意若しくは過失又は第8条の遵守事項に違反する行為によって、共用施設等の破損等の損害を研究所に与えた場合には、研究所は、その損害賠償を利用者及びその従業員に請求することができ

ます。

2 利用者による共用施設等の利用行為に起因して又は関連して第三者が損害を受けたとして、第三者から研究所に請求がなされた場合には、利用者は当該請求により研究所に発生した費用及び損害を負担するものとします。

3 前項の規定は、前条第5項の利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして第三者から研究所に請求がなされた場合に準用されるものとします。

(利用契約の有効期間)

第14条 本利用契約は、回答書に記載した利用の期間に限り有効とします。ただし、本約款中、第4条第3項の規定は利用の期間の終了後1年間有効とし、第9条の規定は利用の期間終了後5年間有効とし、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第20条及び第21条の規定は利用の期間終了後も有効とします。

(製造物責任等)

第15条 研究所及び利用者は、共用施設等を利用した製造については、専ら利用者が製造者としての責任を負うものであることを確認するものとします。

2 研究所及び利用者は、共用施設等の利用による製造物及びその製造方法について、研究所が製造物責任を含む一切の法的責任を負わないことを確認するものとします。

3 第13条第2項の規定は、共用施設等の利用による製造物について、第三者から研究所に製造物責任があるとして請求がなされた場合に準用します。

(国等からの委託事業に基づく成果の公開及び報告)

第16条 利用者が国等からの委託事業に基づく成果の公開を前提として共用施設等を利用する場合には、研究所及び利用者は、共用施設等の利用の終了後、成果を公開しなければなりません。ただし、成果中に公開することにより業務に支障を来す部分が含まれているとして、利用者から当該部分を公開しないよう申入れがあり、かつ、公開しないことにつき相当の理由があると認められる場合には、当該部分の全部又は一部を公開しないことができます。

2 利用者は、前項本文に規定する場合は、共用施設等を利用した後1か月以内に、利用報告書を提出しなければなりません。ただし、研究所が利用者からの申出により利用報告書を提出しないことについて相当の理由を認めたときは、提出を省略することができます。

3 利用者は、第1項本文に規定する場合において、その公開する成果に関し、ねつ造、改ざん及び盗用、並びに不適切なオーサiership、二重投稿等を行ってはなりません。

(無断利用)

第17条 利用者は、回答書に記載した利用の期間を超えて共用施設等を利用することはできません。

2 利用者が研究所の書面による同意を得ることなく、回答書に記載した利用の期間以外の期間に共用施設等を利用した場合には、利用者は、研究所に対して、使用損害金として、当該期間に係る利用料等(第6条第1項第2号から第5号までを除く。)の倍額に相当する金銭を支払わなければなりません。

(譲渡の禁止)

第18条 利用者は、研究所の事前の書面による同意なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供してはなりません。

2 前項に反して、利用者が本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供したことにより研究所に費用負担又は損害が生じた場合には、利用者は、研究所に対して、合理的な弁護士費用を含む費用を支払い、損害を賠償する義務を負わなければなりません。

(約款の変更)

第19条 本約款を変更する場合には、本約款に特に定めない限り、既に締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとします。

2 本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容、その効力発生時期等について、研究所のウェブページに掲載します。

(準拠法)

第20条 本利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

(合意管轄)

第21条 研究所及び利用者は、本利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

(その他)

第22条 本約款に関し疑義が生じた場合又は本約款に記載のない事項若しくはその取り決め等については、研究所と利用者で誠意をもってその都度協議するものとします。

この約款は、平成25年12月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年7月1日から適用する。

- 一 別表第1 表4
- 二 別表第1 表5
- 三 別表第2 2. 中の「、NPF並びにGreFONの施設」

附 則（一部改正）

- 1 この約款は、平成26年10月1日から施行する。
- 2 この約款の施行前に締結した契約については、当該契約を変更又は終了するまでの間は、なお従前の例による。

附 則（一部改正）

この約款は、平成27年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

- 1 この約款は、平成27年6月1日から施行する。
- 2 この約款の施行前に締結した契約については、当該契約を変更又は終了するまでの間は、なお従前の例による。

附 則（一部改正）

この約款は、平成27年11月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成28年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成28年12月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成29年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成29年7月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成30年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成30年10月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成30年11月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成31年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和元年10月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和2年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和2年10月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和2年12月15日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和3年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和3年10月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和4年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和4年8月1日から施行する。

(別表第1)

共用施設等一覧

1. スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 (以下「SCR」という。)

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
1	L01-104	ArF 液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
	L01-103	ArF 液浸露光装置	Nikon	NSR-S610C
2	M01-08	KrF レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	M01-10	KrF 露光装置	Canon	FPA-5000ES3
3	U01-102	i 線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	U01-101	IR アラインメント付 i 線露光装置	Canon	FPA-5510iZs
4	L01-104c	ArF 液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
5	M01-08c	KrF レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
6	U01-102c	i 線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
7	M01-04	レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
8	B03-07	プラズマ CVD 装置	ASM	Eagle-12
9	M03-06	プラズマ CVD 装置	ASM	Eagle-12 Rapidfire
10	B03-06	プラズマ CVD 装置	Novellus systems	VECTOR
11	F03-103	プラズマ CVD 装置	Novellus systems	VECTOR
12	M03-01	高密度プラズマ CVD 装置	Novellus systems	Concept 3 Speed
13	P03-101	高密度プラズマ CVD 装置	三菱重工	MAPLE
14	M03-14	High-k ALD 装置	東京エレクトロン	Trias-ALD
15	M06-04	メタル CVD 装置	東京エレクトロン	Trias-W
16	F03-07	窒化膜 LP-CVD 装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
17	M03-03	酸化膜 LP-CVD (TEOS) 装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
18	P03-103	Doped-Si LP-CVD 装置	日立国際電気	DJ-1226V-DF
19	U03-101B	プラズマ CVD 装置	Applied Materials	PRODUCER GT Staircase
20	B06-101	バリアシー ドスパッタ装置	Applied Materials	Endura2 EnCoReII Ta/Cu
21	F06-101	新材料スパッタ装置	キャノンアネルバ	iarim C-7100GT
22	M06-03	メタルスパッタ装置	キャノンアネルバ	COSMOS I-1201
23	M06-07	メタルスパッタ装置	ULVAC	ENTRON W-300
24	B06-102	Cu メッキ装置	Novellus systems	SABRE NEXT
25	P03-105	Ge エピ装置	キャノンアネルバ	FC7200
26	M02-04	Poly-Si エッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/Axiom
27	M02-05	メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/ASPII
28	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura Enabler/DPS232
29	M02-01	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-0x/DRM-0x
30	M02-10	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius DRM-0x/SCCM-Poly
31	B02-01	Low-k エッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-0x
32	F02-101	新材料エッチング装置	日立ハイテクノロジーズ	U-8150
33	B02-03	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/RPA300
34	M02-07	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	μ ASH300
35	P02-105	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/ μ ASH300
36	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300V
37	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置	住友重機械	SHX
38	M03-101	RTA/RTP 装置	Applied Materials	Radiance
39	M04-02	ゲート酸化窒化 RTO/RTP 装置	東京エレクトロン	Trias SPA300

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
40	B04-01	縦型アニール装置	光洋サーモシステム	VF-5700B
41	M04-101	縦型酸化炉	東京エレクトロン	ALPHA-303i-K
42	M07-15	バッチ式洗浄装置	東京エレクトロン	UW300Z
43	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置	SES	VENUS
44	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置	S-TEC	SFAW-1201-008
45	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置	東京エレクトロン	ZETA 300 BE
46	U07-103c	Si 裏面研削研磨装置洗浄ユニット	ディスコ	DGP8761SC
47	M07-02	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN MP-3000
48	M07-101	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
49	M07-102	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
50	P07-105	枚葉式洗浄装置	カナメックス	KC-A300CBT
51	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置	SEZ	SEZ323
52	P07-103	小口径対応枚葉式洗浄装置	ジャパングリエイト	SRWC-12801-8P-2C
53	M07-09	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
54	M07-12	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
55	N07-101	STI、W CMP 装置	東京精密	ChaMP-332M A-FP-3000M
56	B07-101	Cu CMP 装置	東京精密	ChaMP-332M A-FP-3000M
57	P07-101	CMP 装置	荏原製作所	F-REX300E
58	B02-101D	Si 深掘りエッチング装置	Applied Materials	Centura Silvia
59	U03-101A	プラズマ CVD 装置	Applied Materials	PRODUCER GT InViaII
60	U06-101	Cu めっき装置	東京エレクトロン	NEXX Cu ECD
61	U07-101	Oxide CMP 装置	Applied Materials	Reflexion LK Oxide
62	U12-102	ウェハ接合装置	タツモ	WS3000
63	U07-102	ウェハエッジトリミング装置	ディスコ	DFD6860
64	U07-103	Si 裏面研削研磨装置	ディスコ	DGP8761HC
65	AF03-16	真空蒸着装置	エイコーエンジニアリング	VX-30-S
66	M04-08	評価用小片アニール装置	ULVAC	VHC-P616CP-S
67	M08-55	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
68	P08-116	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
69	M08-07	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5
70	M08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5X
71	P08-108	分光エリプソ膜厚測定装置	日本セミラボ	μ SE-2500-A
72	I08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	J. A. Woollam	M-2000X
73	AF08-12	単色エリプソ膜厚測定装置	ファイブラボ	MARY-102SM
74	P08-104	反射分光膜厚測定装置	Filmetrics	F50-EXR
75	M12-08	蛍光 X 線膜厚測定装置	リガク	System 3272E
76	F08-04	X 線回折装置	リガク	TTR In-plane XRD
77	B12-101	反り/膜応力自動測定装置	FSM	128LC2C
78	M08-12	反り/膜応力測定装置	FSM	128L
79	P08-105	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
80	P08-106	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
81	P08-107	全反射蛍光 X 線分析装置	リガク	TXRF 310Fab
82	P08-109	自動濃縮装置	イアス	Expert
	P08-113	ICP-MS 質量分析装置	PerkinElmer	NexION 2000
83	M08-10	シート抵抗測定装置	KLA-Tencor	RS-100
84	M08-25	シート抵抗測定装置	日立国際電気	VR-120/08

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
85	P08-102	シート抵抗測定装置	日立国際電気	VR300DSE
86	I08-110	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジーズ	CG5000
87	L08-103	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジーズ	CG4000
88	P08-101	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジーズ	S-9380 II
89	P08-103	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジーズ	S-9380 II
90	P08-115	レビューSEM	Applied Materials	SEMVision G6
91	M08-40	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110F
92	M08-50	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110 F
93	M12-101	光学顕微鏡	オリンパス	AL110
94	M12-102	光学顕微鏡	オリンパス	AL120
95	P08-110	超音波顕微鏡	Sonoscan	FastLine P300
96	P08-111	高精度微細形状測定機	小坂研究所	ET4000L
97	P08-112	赤外線顕微鏡システム	清和光学製作所	DSI-300SA-IR
98	P08-114	赤外線拡大鏡	タツモ	BL-3000A
99	J04-106	ヘリウムイオン顕微鏡	Carl Zeiss	ORION Plus
100	B08-02-01	FIB 装置	日立ハイテクノロジーズ	FB2100
101	AF08-402	走査透過電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	HD-2700
102	B08-02	走査透過電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	HD-2000
103	J03-117	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-4700
104	M08-04	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-5000
105	B08-12	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-5200
106	AF08-14	X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ	ESCA-1800
107	B10-06	IR-OBIRCH 解析装置	浜松ホトニクス	μ AMOS
108	J03-116	昇温脱離ガス分析装置	電子科学	WA1000S/W
109	J03-114	赤外分光分析装置	Digilab	Excalibur FTS-3000
110	J03-118	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073B/N9201A
111	M08-42 M10-01	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073A
112	M10-05	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4076
113	F10-01	セミオートプローバ テスター	Cascade Agilent	S300-861 4156C/4284A/4294A
114	M10-04 M08-47	セミオートプローバ テスター	Cascade Agilent	S300-561 4156C/4284A/4294A
115	J03-115	水銀プローバ	Solid State Measurements	SSM 5130
116	SIM-01	露光シミュレータ	KLA-Tencor	PROLITH

2. 先端ナノ計測施設（以下「ANCF」という。）

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	ANCF001	陽電子プローブマイクロアナライザー (PPMA)	2-4C 棟 B023	プローブ分析装置
2	ANCF002	超伝導蛍光収量 X 線吸収微細構造分析装置 (SC-XAFS)	KEK-PF	X 線分析装置
3	ANCF014	極端紫外光光電子分光装置 (EUPS)	2-1 棟 A324	光電子分光装置
4	ANCF015	超伝導蛍光 X 線検出器付走査型電子顕微鏡 (SC-SEM)	2-10 棟 B013	分析電子顕微鏡
5	ANCF016	可視・近赤外過渡吸収分光装置 (VITA)	2-10 棟 1112、2-10 棟 033	レーザー分光装置
6	ANCF017	リアル表面プローブ顕微鏡 (RSPM)	2-1D 棟 124、2-1D 棟 125	プローブ顕微鏡
7	ANCF018	固体 NMR 装置 (SSNMR)	5-3 棟 1203、5-3 棟 1205	NMR 分析装置

3. 超伝導量子回路試作施設（以下「Qufab」という。）

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	Qufab001	i線ステッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置
2	Qufab002	インライン型コータディベロッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置
3	Qufab003	セミオートディベロッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置
4	Qufab004	ウェハー洗浄装置	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
5	Qufab005	有機洗浄装置A	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
6	Qufab006	有機洗浄装置B	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
7	Qufab007	Nb-Al ジョセフソン接合作製装置 [In-situ 分析器&オゾン酸化器付]	CR2 クリーンルーム	成膜装置
8	Qufab008	Nb-Al ジョセフソン接合作製装置 [標準型]	CR2 クリーンルーム	成膜装置
9	Qufab009	NbN ジョセフソン素子作製装置	CR2 クリーンルーム	成膜装置
10	Qufab010	マルチターゲット(六源)スパッタ装置	CR4 クリーンルーム	成膜装置
11	Qufab011	絶縁膜作製装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置
12	Qufab012	TEOS-CVD	CR3 クリーンルーム	成膜装置
13	Qufab013	反応性イオンエッチング装置 Samco-II	CR2 クリーンルーム	エッチング装置
14	Qufab014	反応性イオンエッチング装置 Samco-III	CR2 クリーンルーム	エッチング装置
15	Qufab015	反応性イオンエッチング装置 (Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置
16	Qufab016	ICP型反応性イオンエッチング装置 (Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置
17	Qufab017	イオンミリング装置	CR3 クリーンルーム	エッチング装置
18	Qufab018	酸系ウェットエッチング装置	CR1 イエロールーム	エッチング装置
19	Qufab019	マニュアルプローバ	CR3 クリーンルーム	測定装置
20	Qufab020	シート抵抗測定装置	CR3 クリーンルーム	測定装置
21	Qufab021	ナノサーチ顕微鏡	CR3 クリーンルーム	測定装置
22	Qufab022	レーザー顕微鏡	CR1 イエロールーム	測定装置
23	Qufab023	段差計	CR3 クリーンルーム	測定装置
24	Qufab024	CMP1	CR3 クリーンルーム	表面処理装置
25	Qufab025	CMP2	CR7 クリーンルーム	表面処理装置
26	Qufab026	有機ドラフトチャンバー	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
27	Qufab027	無機ドラフトチャンバー	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
28	Qufab028	光学顕微鏡	CR1 イエロールーム	測定装置
29	Qufab029	ICP型反応性イオンエッチング装置 (フッ素系)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置
30	Qufab030	ICP型反応性イオンエッチング装置 (塩素系)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置
31	Qufab031	光学膜厚計	CR3 クリーンルーム	測定装置
32	Qufab032	顕微分光光学膜厚計	CR3 クリーンルーム	測定装置
33	Qufab033	クラスタースパッタ装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置
34	Qufab034	アッシング装置	CR5 クリーンルーム	エッチング装置
35	Qufab035	ALD装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置

No.	装置番号	施設等名称	備考	
36	Qufab036	斜め蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置
37	Qufab037	走査電子顕微鏡	CR5 クリーンルーム	測定装置
38	Qufab038	デバイス評価装置	1136室実験室	測定装置
39	Qufab039	シリコン深堀エッチング装置A	CR7 クリーンルーム	エッチング装置
40	Qufab040	シリコン深堀エッチング装置B	CR7 クリーンルーム	エッチング装置
41	Qufab041	バンプ形成用成膜装置	CR9 クリーンルーム	成膜装置
42	Qufab042	フリップチップボンダー	CR8 クリーンルーム	表面処理装置

4. ナノプロセッシング施設（以下「NPF」という。）

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	NPF001	電子ビーム描画装置 (CRESTEC)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
2	NPF003	イオンコーター (FIB 付帯) (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
3	NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡 [S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
4	NPF005	低真空走査電子顕微鏡	2F 一般実験室	観察・計測・分析
5	NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
6	NPF008	スピニングコーター (フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
7	NPF009	コンタクトマスクアライナー [MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
8	NPF010	反転露光用全面 UV 照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
9	NPF011	i 線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィー
10	NPF012	ドラフトチャンバー (右)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
11	NPF013	ドラフトチャンバー (左)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
12	NPF014	有機ドラフトチャンバー 1	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
13	NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー 1	CR1 クリーンルーム	表面処理
14	NPF016	スターラーウォーターバス [SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理
15	NPF017	スマートウォーターバス [TB-1N] (フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
16	NPF018	反応性イオンエッチング装置 (RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング
17	NPF019	多目的エッチング装置 (ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング
18	NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理
19	NPF022	UV オゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理
20	NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜
21	NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜
22	NPF025	スパッタ成膜装置 (芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜
23	NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜
24	NPF030	プラズマ CVD 薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜
25	NPF031	原子層堆積装置_1 [FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
26	NPF032	クロスセクションポリッシャー (ALD 付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
27	NPF033	アルゴンミリング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング
28	NPF034	集束イオンビーム加工観察装置 (FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
29	NPF035	イオンコーター (SEM 付帯) (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
30	NPF038	二次イオン質量分析装置 (D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析

No.	装置番号	施設等名称	備考	
31	NPF039	オゾンクリーナー(SIMS 付属)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
32	NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理
33	NPF042	クリーンオープン	CR1 イエロールーム	熱処理
34	NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理
35	NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
36	NPF046	走査プローブ顕微鏡 SPM_1 [NanoscopeIV/Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
37	NPF047	走査プローブ顕微鏡 SPM_2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	観察・計測・分析
38	NPF048	ナノサーチ顕微鏡 SPM_3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
39	NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析
40	NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
41	NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
42	NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
43	NPF053	ワイヤーボンダー (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
44	NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他
45	NPF055	スクライパー	CR4 クリーンルーム	その他
46	NPF056	研磨機	CR4 クリーンルーム	その他
47	NPF057	ラッピングマシン(CMP)	CR4 クリーンルーム	その他
48	NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
49	NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
50	NPF063	分光エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
51	NPF064	解析用 PC(分光エリプソメータ用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
52	NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
53	NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
54	NPF067	解析用 PC(CAD 及び SPM, FT-IR, Raman 用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
55	NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
56	NPF070	X 線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
57	NPF071	薄膜エックス線回折装置	2F 一般実験室	観察・計測・分析
58	NPF072	微小部蛍光 X 線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
59	NPF073	解析用 PC(CAD 及び X 線用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
60	NPF074	エックス線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
61	NPF075	解析用 PC(XPS 用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
62	NPF076	解析用 PC(一般解析用)_1	2F データ解析室	その他
63	NPF077	解析用 PC(一般解析用)_2	2F データ解析室	その他
64	NPF078	解析用 PC(一般解析用)_3	2F データ解析室	その他
65	NPF079	解析用 PC(一般解析用)_4	2F データ解析室	その他
66	NPF080	ヘリウムイオン顕微鏡	SCR 産学官連携研究棟	観察・計測・分析
67	NPF081	プラズマ CVD 薄膜堆積装置 (SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜

No.	装置番号	施設等名称	備考	
68	NPF082	化合物半導体エッチング装置 (ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング
69	NPF084	デジタルマイクロスコープ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
70	NPF085	物理特性測定装置 (PPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
71	NPF086	マニュアルウエハプローパー (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
72	NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡 [S4500/FE-SEM] (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
73	NPF089	赤外線ランプ加熱炉 (RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理
74	NPF091	自動塗布現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
75	NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
76	NPF093	高速電子ビーム描画装置 (エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
77	NPF094	解析用 PC (CAD 及び近接効果補正用)	2F データ解析室	リソグラフィー
78	NPF095	RF-DC スパッタ成膜装置 (芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜
79	NPF096	単波長エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
80	NPF098	ECR スパッタ成膜・ミリング装置	CR1 クリーンルーム	成膜
81	NPF099	サムコ原子層堆積装置_2[AD-100LP]	CR5 クリーンルーム	成膜
82	NPF100	解析用 PC (L-Edit レイアウト・エディタ)	2F データ解析室	その他
83	NPF101	S i 深堀エッチング装置 [PlasmaPro_100]	CR5 クリーンルーム	エッチング
84	NPF102	原子層堆積装置_3 [FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
85	NPF103	原子層堆積装置_3 付帯 X P S 装置 (アルバック・ファイ)	CR5 クリーンルーム	成膜
86	NPF104	原子層堆積装置_4 [FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
87	NPF105	ピュアオゾン供給装置	CR5 クリーンルーム	成膜
88	NPF106	小型自動現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
89	NPF107	3次元電界放出形走査電子顕微鏡 (エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
90	NPF108	イオンコーター (エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
91	NPF109	6インチ電子ビーム真空蒸着装置 (アールデック)	CR1 クリーンルーム	成膜
92	NPF110	レーザー描画装置 [DWL66+]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
93	NPF111	酸アルカリドラフトチャンバー_2	CR1 クリーンルーム	表面処理
94	NPF112	有機ドラフトチャンバー_2	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
95	NPF113	スピコーター (EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー

5. 蓄電池基盤プラットフォーム (以下「BRP」という。)

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	BRP-01	中型電池非破壊観察装置 X線 CT スキャナー (東芝 TOSCANER-34500FD)	関西センターC-2 棟 1002 室	エックス線装置
2	BRP-02	中型電池物性解析装置 レーザーラマン顕微鏡 (NanoPhoton RAMANtouch VIS-NIR-LT)	関西センターC-1 棟 1103-1 室	分光装置
3	BRP-03	中型電池物性解析装置 カルベ式熱量計 (Setaram C-600)	関西センターC-1 棟 1103-1 室	分析装置
4	BRP-04	中型電池物性解析装置 熱分析装置 (島津 DTG-60、TMA-60、DSC-60plus)	関西センターC-1 棟 1103-1 室	分析装置

6. MEMS研究開発拠点（以下「MEMS」という。）

No.	装置番号	施設等名称	備考		
			試料寸法	設置場所	用途
1	MEMS001	ウェハディップ洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
2	MEMS002	ウェハスピンド洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
3	MEMS003	有機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
4	MEMS004	異方性ウェットエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
5	MEMS005	IPA ベーパー乾燥機	200mm	TKB812-F	処理
6	MEMS006	i-線ステッパ	200mm	TKB812-F	加工
7	MEMS007	マスク露光装置	150mm/200mm	TKB812-F	加工
8	MEMS008	マスクレス露光装置	500mm 角以下	TKB812-F	加工
9	MEMS010	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-F	分析・評価
10	MEMS011	Si 酸化膜プラズマ CVD 装置	200mm/300mm	TKB812-F	加工
11	MEMS012	スパッタ	200mm	TKB812-B	加工
12	MEMS013	酸化炉	200mm	TKB812-F	加工
13	MEMS014	アニール炉	200mm	TKB812-F	加工
14	MEMS015	Si 窒化膜減圧 CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
15	MEMS016	ポリ Si 減圧 CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
16	MEMS017	金属膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
17	MEMS018	Si 酸化膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
18	MEMS019	8"Si 深掘ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
19	MEMS020	12"Si 深掘ドライエッチング装置	300mm	TKB812-F	加工
20	MEMS021	犠牲層ドライエッチング装置	100/150/200mm	TKB812-F	加工
21	MEMS022	アッシャー	200mm/300mm	TKB812-F	加工
22	MEMS023	光学検査顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
23	MEMS024	段差測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
24	MEMS025	エリブソメーター	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
25	MEMS026	膜厚測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
26	MEMS027	ウェハ塵埃検査装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
27	MEMS028	干渉型表面形状評価装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
28	MEMS029	シート抵抗プローバー	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
29	MEMS030	赤外線レーザー顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
30	MEMS031	レーザー顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
31	MEMS032	ブレードダイサー	300mm 以下	2A-CR	加工
32	MEMS033	レーザーステルスダイサー	200mm 以下	2A-CR	加工
33	MEMS034	光学顕微鏡	300mm 以下	2A-CR	分析・評価
34	MEMS035	大面積ナノインプリント装置	200mm 角以下	2A-CR	加工
35	MEMS036	電子ビーム/抵抗蒸着装置	200mm/300mm	TKB812-B	加工
36	MEMS037	熱処理装置	200mm	TKB812-B	加工
37	MEMS038	チップ to ウェハ接合装置	100/150/200/300mm	TKB812-B	加工
38	MEMS039	ウェハ to ウェハ接合装置	100/150/200mm	TKB812-B	加工

No.	装置番号	施設等名称	備考		
			試料寸法	設置場所	用途
39	MEMS040	パリレンコータ	100mm	2G-CR	加工
40	MEMS041	光表面処理装置	200mm	TKB812-B	処理
41	MEMS042	12"ウェハ常温接合装置	100/150/200/300mm	3F-CR	加工
42	MEMS043	測長 SEM	200mm	TKB812-B	分析・評価
43	MEMS044	分析 SEM	100/150/200/300mm	TKB812-B	分析・評価
44	MEMS045	超音波顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
45	MEMS046	赤外線顕微鏡	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
46	MEMS047	薄膜応力評価装置	200mm	TKB812-B	分析・評価
47	MEMS048	X線 CT 評価装置	200mm/300mm	TKB812-B	分析・評価
48	MEMS049	テスタープローバ	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
49	MEMS050	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
50	MEMS053	ダイシエアテスタ	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価
51	MEMS054	大面積コーターディベロッパ	500mm 角以下	TKB812-F	加工
52	MEMS055	レジストスプレーコータ	200mm 角以下	2G-CR	加工
53	MEMS056	反応性イオンエッチング装置	200mm	2G-CR	加工
54	MEMS058	無機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
55	MEMS059	レジスト塗布現像装置	200mm 以下	TKB812-F	加工
56	MEMS060	イオンミリング装置	200mm 以下	TKB812-B	加工
57	MEMS061	電界放射型 SEM	100mm 以下	2A 実験室	分析・評価
58	MEMS062	4"Si 深掘ドライエッチング装置	100mm 以下	2G-CR	加工
59	MEMS063	4"スパッタ装置	100mm 以下	2G-CR	加工
60	MEMS064	化学ドラフト	100mm 以下	2G-CR	加工
61	MEMS065	4"酸化炉	100mm 以下	2G-CR	加工
62	MEMS066	4"フォトリソグラフィ設備	100mm 以下	2G-CR	加工・処理
63	MEMS067	レーザ描画装置	100mm 以下	2G-CR	加工
64	MEMS068	小型ナノインプリント装置	20mm 角以下	2G-CR	加工
65	MEMS069	自動光学顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
66	MEMS070	レーザードップラー測定器	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
67	MEMS071	フーリエ変換赤外分光装置	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
68	MEMS072	小口径スパッタ	100mm 以下	TKB812-B	加工
69	MEMS073	マニュアルプローバ	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価

7. 先端バイオ計測施設（以下「BIO」という。）

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	BIO-001	糖鎖プロファイル解析システム	6-9 棟 5527	測定装置
2	BIO-002	植物転写因子相互作用解析システム	6-8 棟 2205	測定装置
3	BIO-003	細胞内相互作用解析システム	6-8 棟 2205	測定装置
4	BIO-004	構成糖分析システム	6-8 棟 2203	測定装置

8. 身体動作解析産業プラットフォーム（以下「MAP」という。）

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	MAP-001	モーションキャプチャカメラ	四国センター実験棟・01001室	処理
2	MAP-002	床反力計	四国センター実験棟・01001室	処理
3	MAP-003	床反力計	四国センター実験棟・01001室	処理
4	MAP-004	床反力測定階段	四国センター実験棟・01001室	処理
5	MAP-005	解析用ワークステーション	四国センター研究棟1・2008室	処理
6	MAP-006	終末糖化物（AGEs）測定器	四国センター実験棟・01001室	処理
7	MAP-007	血圧脈波測定装置	四国センター実験棟・01001室	処理
8	MAP-008	下肢筋力測定器	四国センター実験棟・01001室	処理
9	MAP-009	モバイル心電計	四国センター実験棟・01001室	処理
10	MAP-010	モバイル心電計	四国センター実験棟・01001室	処理
11	MAP-011	トレッドミル	四国センター実験棟・01001室	処理
12	MAP-012	体組成計（BIA装置）	四国センター実験棟・01001室	処理
13	MAP-013	モーションレコーダ	四国センター実験棟・01001室	処理
14	MAP-014	光脳機能イメージング装置	四国センター実験棟・01001室	処理

(別紙第1)

利用料等の算定方式について

第6条第4項の算定方式は、以下のとおり。

1. SCR及びQufabの標準レシピを使用する工程を利用した場合

① 共用施設等使用料(第6条第1項第1号)：

下表の(1)に定める共用施設等使用料単価に使用したウエハ数及び工程数の積を乗じた額。

② 運転費(第6条第1項第2号)：

研究所の役職員等から同装置の操作、運転等の役務提供を受けた場合には、下表の(2)に定める運転費単価に使用したウエハ数及び工程数の積を乗じた額

③ 技術指導費等(第6条第1項第3号及び第4号)：

研究所の役職員等から同装置の操作及び運転方法、試料等の作製方法、データ等の解析方法等についての技術指導を受けた場合又は研究所の役職員等から同装置を用いた観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を受けた場合には、下表の(3)に定める技術指導費等単価に従事時間を乗じた額

④ 追加料金(第6条第1項第5号)：

追加的に必要な作業等が発生する場合には、以下に定める額。なお、以下の追加的に必要な作業等は、いずれも第2条第1項の「利用」に含まれるものとする。

ア 改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

イ 復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

ウ 他の共用施設等の利用に係る経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関(民間企業を含む。以下同じ。)の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

オ 上記エの場合における研究所の役職員等の従事に要する経費：上記エの場合における研究所の役職員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額

カ その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

⑤ 運営管理費(第6条第1項第6号)：

上述①～④の額に15パーセントを乗じた額

(1) 共用施設等使用料

(a) 共用施設等使用料単価	(b) 使用ウエハ数×工程数	(a) × (b) 共用施設等使用料
円	枚・回	円

(2) 運転費

(c) 運転費単価	(d) 使用ウエハ数×工程数	(c) × (d) 運転費
円	枚・回	円

(3) 技術指導費等

(e) 技術指導費等単価	(f) 従事時間	(e) × (f) 技術指導費等
円	時間	円

(3) の金額は消費税等抜きである。

(a) (c) (e) の単価は共用施設等ごとに設定し、毎年度改定する。

利用が不可能になり、又は利用を中止した場合における仕掛品のウエハに係る共用施設等使用料及び運転費については、仕掛中の工程までの利用時間に相当する額とする。

なお、利用者の規模等を考慮し、利用料等を調整する場合もある。

2. SCR、ANCF 及びQufab のチューニングが必要な工程を利用した場合、並びに NPF、BRP、MEMS 及び MAP を利用した場合

① 共用施設等使用料（第6条第1項第1号）：

下表の（1）に定める時間あたりの共用施設等使用料単価に使用時間に乗じた額。

② 運転費（第6条第1項第2号）：

研究所の役職員等から同装置の操作、運転等の役務提供を受けた場合には、下表の（2）に定める運転費単価に従事時間に乗じた額

③ 技術指導費等（第6条第1項第3号及び第4号）：

研究所の役職員等から同装置の操作及び運転方法、試料等の作製方法、データ等の解析方法等についての技術指導を受けた場合又は研究所の役職員等から同装置を用いた観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を受けた場合には、下表の（3）に定める技術指導費等単価に従事時間に乗じた額

④ 追加料金（第6条第1項第5号）：

追加的に必要な作業等が発生する場合には、以下に定める額。なお、以下の追加的に必要な作業等は、いずれも第2条第1項の「利用」に含まれるものとする。

ア 改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

イ 復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

ウ 他の共用施設等の利用に係る経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関（民間企業を含む。以下同じ。）の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

オ 上記エの場合における研究所の役職員等の従事に要する経費：上記エの場合における研究所の役職員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額

カ その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

⑤ 運営管理費（第6条第1項第6号）：

上述①～④の額に15パーセントに乗じた額

(1) 共用施設等使用料

(a) 共用施設等使用料単価	(b) 使用時間	(a) × (b) 共用施設等使用料
円	時間	円

(2) 運転費

(c) 運転費単価	(d) 従事時間	(c) × (d) 運転費
円	時間	円

(3) 技術指導費等

(e) 技術指導費等単価	(f) 従事時間	(e) × (f) 技術指導費等
円	時間	円

(3) の金額は、消費税等抜きである。

(a) (c) (e) の単価は共用施設等ごとに設定し、毎年度改定する。

文部科学省委託事業のために利用する場合には、第6条第1項ただし書きにより運営管理費は含まないものと

し、及び同条第2項により通常の単価より低い単価を設定する。
なお、利用者の規模等を考慮し、利用料等を調整する場合もある。

3. ANCF の標準レシピを使用する工程を利用した場合、及び BIO を利用した場合

① 共用施設等使用料（第6条第1項第1号）：

下表の（1）に定める共用施設等使用料単価に使用した試料数及び工程数の積を乗じた額。

② 運転費（第6条第1項第2号）：

研究所の役職員等から同装置の操作、運転等の役務提供を受けた場合には、下表の（2）に定める運転費単価に使用した試料数及び工程数の積を乗じた額

③ 技術指導費等（第6条第1項第3号及び第4号）：

研究所の役職員等から同装置の操作及び運転方法、試料等の作製方法、データ等の解析方法等についての技術指導を受けた場合又は研究所の役職員等から同装置を用いた観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を受けた場合には、下表の（3）に定める技術指導費等単価に従事時間を乗じた額

④ 追加料金（第6条第1項第5号）：

追加的に必要な作業等が発生する場合には、以下に定める額。なお、以下の追加的に必要な作業等は、いずれも第2条第1項の「利用」に含まれるものとする。

ア 改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

イ 復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

ウ 他の共用施設等の利用に係る経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関（民間企業を含む。以下同じ。）の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

オ 上記エの場合における研究所の役職員等の従事に要する経費：上記エの場合における研究所の役職員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額

カ その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

⑤ 運営管理費（第6条第1項第6号）：

上述①～④の額に15パーセントを乗じた額

(1) 共用施設等使用料

(a) 共用施設等使用料単価	(b) 使用試料数×工程数	(a) × (b) 共用施設等使用料
円	個・回	円

(2) 運転費

(c) 運転費単価	(d) 使用試料数×工程数	(c) × (d) 運転費
円	個・回	円

(3) 技術指導費等

(e) 技術指導費等単価	(f) 従事時間	(e) × (f) 技術指導費等
円	時間	円

(3) の金額は、消費税等抜きである。

(a) (c) (e)の単価は共用施設等ごとに設定し、毎年度改定する。

利用が不可能になり、又は利用を中止した場合における仕掛品の試料に係る共用施設等使用料及び運転費については、仕掛中の工程までの利用時間に相当する額とする。

文部科学省委託事業のために利用する場合には、第6条第1項ただし書きにより運営管理費は含まないものとし、及び同条第2項により通常の単価より低い単価を設定する。

なお、利用者の規模等を考慮し、利用料等を調整する場合もある。